

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 01025573
PUBLICATION DATE : 27-01-89

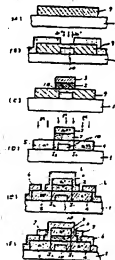
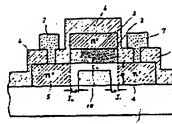
APPLICATION DATE : 22-07-87
APPLICATION NUMBER : 62181055

APPLICANT : HITACHI LTD;

INVENTOR : KONISHI NOBUTAKE;

INT.CL. : H01L 29/78 H01L 27/12

TITLE : THIN FILM TRANSISTOR



ABSTRACT : PURPOSE: To provide a TFT capable of being reduced in off-current upon light irradiation by producing specific density defects only in a specific area within a TFT channel region other than space charge regions formed in the vicinity of drain and source junctions.

CONSTITUTION: An islet-like element region 8 is formed by depositing a polycrystalline silicon film of, for example, 1500 Å on an insulating substrate 1 by a reduced pressure CVD method and subjecting the same to patterning. Then, a resist 11 is formed and employed as a mask to yield a high density defect layer 10 by doping the islet-like element region 8 with Ar^+ ions under conditions of acceleration voltage of 110 KeV and the dosage of $1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-2}$. In succession, a SiO_2 film is deposited by an ordinary pressure CVD method, followed by deposition thereon of a polycrystalline silicon film by a reduced pressure CVD method and patterning of the same to form a gate insulating film 2 and a gate electrode 3. In addition, a drain region 5 and a source region 6 are formed by ion-doping of p^+ for example. Furthermore, an interlayer insulating film is formed by the ordinary pressure CVD method, through which contact holes are made in turn. Finally, Al is vapordeposited and subjected to patterning to form a contact electrode 7 and hence a TFT.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭64-25573

⑬ Int. Cl.⁴

H 01 L 29/78
27/12

識別記号

3 1 1

庁内整理番号

H-7925-5F
7514-5F

⑭ 公開 昭和64年(1989)1月27日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑮ 発明の名称 薄膜トランジスタ

⑯ 特 願 昭62-181055

⑰ 出 願 昭62(1987)7月22日

⑱ 発 明 者 河 内 玄 士 明 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内
⑲ 発 明 者 吉 村 雅 夫 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内
⑳ 発 明 者 小 野 記 久 雄 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内
㉑ 発 明 者 小 西 信 武 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内
㉒ 出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
㉓ 代 理 人 弁理士 小川 勝男 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

薄膜トランジスタ

2. 特許請求の範囲

1. 絶縁基板上に形成された多結晶半導体層に第一の導電層を有するソース及びドレイン領域を有し、この両領域間にゲート絶縁膜を介してゲート電極を有するMOS型半導体素子において、ゲート絶縁膜は半導体の界面、ドレイン接合面、ソース接合面および絶縁基板で覆われた領域内で、絶縁基板に接し、かつゲート絶縁膜/半導体界面、ドレイン接合面およびソース接合面から特定の距離離れた領域にのみキャリアの再結合中心となる欠陥を半導体の半導体中における深度以上に含む欠陥層を有することを特徴とする薄膜トランジスタ。

2. 特許請求の範囲第1項において、ゲート絶縁膜/半導体界面、ドレイン接合面およびソース接合面から欠陥層までの距離を1000Å以上とする事を特徴とする薄膜トランジスタ。

3. 特許請求の範囲第1項において、欠陥層に含まれる欠陥の密度がフェルミレベル附近において $1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2} \text{ eV}^{-1}$ 以上である事を特徴とする薄膜トランジスタ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、絶縁基板上に形成される半導体薄膜素子に係り、特に、液晶ディスプレイパネル駆動用として使用するのに好適な特性を持つ薄膜トランジスタに関する。

(従来の技術)

近年、絶縁基板上に非晶質あるいは多結晶の半導体で薄膜能動素子を形成する技術開発が盛んに行なわれている。この技術の応用の1つとして、液晶ディスプレイパネル駆動のための薄膜トランジスタマクティブマトリクスがある。(以下薄膜トランジスタをTFTと記す。) 液晶ディスプレイパネルにおいてはその駆動構成上、液晶駆動用のTFTアクティブマトリクスは 10^{-8} eV^{-1} の強い光照射下での使用が不可欠となる

が、このような強い光照射下においてTFTを駆動すると、チャネル領域に光起されるキャリアによってオフ電流が上昇し、このTFTにより液晶を駆動する際に重大な障害となる。この光照射によるオフ特性の劣化を抑制する方法として、半導体薄膜の膜厚を厚くする方法が有効であるが、特開昭61-85368、特開昭61-65476において論じられている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、ドレイン領域、ソース領域を自己整合的に形成するコープレーナ型のTFTにおいては、半導体薄膜を厚くすると、(1)ドレイン領域ソース領域の抵抗が増大してしまう、(2)ゲートをパターンニングする際のプロセス条件が厳しくなる、(3)高品質の半導体膜が得られない、等の問題点があった。

本発明はこのような問題点を解決するものであり、その目的は、半導体膜の膜厚を厚くすること無しに、光照射時のオフ電流が薄膜化した時と同様に小さい特性をもつ構造のTFTを提供することにある。

とにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、TETのチャネル領域内にある特定の領域にのみイオン注入法により 10^{18}cm^{-3} 、 0V^{-1} 以上の密度の欠陥を生成することにより、この領域内での光電流の発生を抑え光照射時のオフ電流の上昇を抑制するもので、更に、ドレイン接合、ソース接合近傍に形成される空間電荷領域を避けて欠陥を生成することにより逆方向リーク電流の増加を防ぐことを特徴とする。

(作用)

本発明のTFTの構造を第1図に示す。図面において高抵抗の高濃度欠陥層10の存在により、実効的なチャネル領域の厚さは t_1 から t_2 へ薄くなることとなり、膜厚を薄くした時と同様に、チャネル領域内に余剰キャリアが光起される。一般に、余剰キャリアの寿命 τ と再結合中心の密度 N_t の間には、

$$\tau = 1/N_t$$

の関係が成立する。欠陥層10内で生成された余剰キャリアの寿命は短く直ちに再結合してほとんど電流に寄与しない。更に、欠陥層10とゲート絶縁膜2の間に欠陥の少ないチャネル領域で生成されるキャリアも、寿命の違いによって膜厚方向に生じるキャリアの濃度傾斜によって欠陥層10の方へ拡散し再結合して消滅する。オフ電流は早く膜厚を t_2 から t_1 へ薄くした時よりも減少の効果が顕著になる。

次に、ドレインおよびソース接合 J_1 、 J_2 と欠陥層10の間に設けた L_0 なる長さのオフセツトの作用について第3図により説明する。

ドレイン、ソース接合 J_1 、 J_2 近傍には空間電荷層30が形成されるが、この領域内に再結合中心となるような欠陥が存在した場合、ゲート電圧を印した時の逆方向リーク電流が増加する。第4図は、第3図に示した従来の構造のTFTにおいて、チャネル領域内の欠陥密度の異なるTFTの特性を比較したものであるが、欠陥密度の増加と共に逆方向オフ特性が $I_A \rightarrow B \rightarrow C$ と低下してい

るのが明らかである。

強い電界の存在する空間電荷領域内に制御中に準位をつくるような欠陥が存在すると、この欠陥を介してのトンネリング、もしくはキャリアの発生によって異常に大きなリーク電流が流れる。このリーク電流の詳細な機構については未だ十分明らかではないが、いずれにせよ、空間電荷領域内の欠陥が多くなると、リーク電流が増加する事は明らかである。従って、本発明のように、接合面と欠陥層の間にオフセツトを設け、空間電荷領域内に欠陥を導入しないようにする事は逆方向リーク特性の劣化を防止する上で非常に重要である。

このオフセツト長さ L_0 は島材となる多結晶あるいは非晶質シリコン膜内のフェルミ準位付近の局在準位密度 N_L によって決定される。例えば、フェルミ準位近傍での局在準位密度 N_L が 10^{18}cm^{-3} 、 0V^{-1} 程度の時、ゼロバイアスでの空間電荷領域幅は1000Å程度となる。逆バイアス印加時の空間電荷層の広がり、およびマスキの合わせ精度を考慮するとオフセツト長さ L_0 は5-

10 μ mとればよい。

(実施例)

以下、第1図に示した本発明の実施例の製作工程を第2図により説明する。絶縁基板1上に減圧CVD法により多結晶シリコン膜を例えば1500Å増殖しパターンニングして島状のゲート領域8を形成。次に図(B)に示すようにレジスト11を形成し、このレジストをマスクとしてイオン注入法により例えばAr⁺イオンを、加速電圧110keV、ドーズ量1 \times 10¹⁴cm⁻²の条件で注入し高濃度欠陥層10を形成する。続いて、レジスト除去した後、常圧CVD法によりSiO₂膜を増殖し、続いて減圧CVD法により多結晶シリコン膜を増殖しパターンニングして図(C)に示すようなゲート絶縁膜2及びゲート電極3を形成する。次に図(D)のように例えばp⁺イオンを打ち込みドレイン領域5、ソース領域6を形成する。続いて図(E)に示すように層間絶縁膜を常圧CVD法により形成し、コンタクトホールを開孔する。最後にA⁺を露着しこれをパターンニングす

る事でコンタクト電極7を形成し、最終的に第1図に示すような構造のTFTが得られる。

本実施例では、多結晶シリコンの場合を例にとつて説明したが、非晶質シリコンを用いた場合にも本発明は同様に適用できる。また、高濃度欠陥を生成する為の注入イオンはAr⁺に限定されるものではなく、シリコン中でドナーやアクセプタとならない電気的に不活性なイオンならば何でも良い。例えば、O⁺、N⁺などでも良い。

(発明の効果)

本発明によれば、半導体膜層を微細化することなく、逆方向リーク特性を悪化させることなく、光照射時のオフ電流を微細化した時と同等もしくはそれ以上に低減できる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

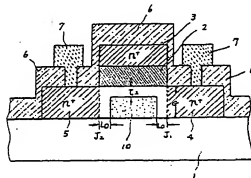
第1図は本発明の実施例の断面の模式図、第2図(A)～(F)は第1図の実施例の製造方法を示す工程図、第3図は従来の構造のTFTの断面模式図、第4図は第3図の構造を有するTFTのオフ特性の、シリコン膜の欠陥密度に対する依

存性を示した図である。

1…絶縁基板、2…ゲート絶縁膜、3…ゲート電極、4…n⁺ドレイン領域、5…n⁺ソース領域、6…層間絶縁膜、7…コンタクト電極、8…チャンネル領域、9…多結晶シリコン層、10…高濃度欠陥層、J_d…ドレイン接合、J_s…ソース接合、L_d…多結晶シリコン膜厚、L_s…欠陥層10とゲート絶縁膜の間の距離、L_o…欠陥層10とドレイン領域4及びソース領域5の間の距離。

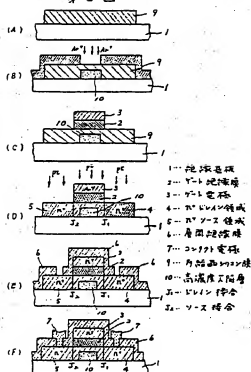
代理人 井澤士 小川啓男

第1図

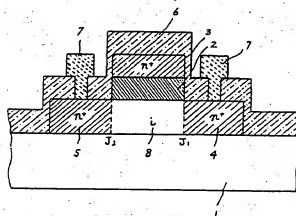


- 1…絶縁基板
- 2…ゲート絶縁膜
- 3…ゲート電極
- 4…n⁺ドレイン領域
- 5…n⁺ソース領域
- 6…層間絶縁膜
- 7…コンタクト電極
- 8…チャンネル領域
- 9…多結晶シリコン層
- 10…高濃度欠陥層
- J_d…ドレイン接合
- J_s…ソース接合
- L_d…ゲート絶縁膜と欠陥層間の距離
- L_o…欠陥層とドレイン領域・ソース領域間の距離

第2図

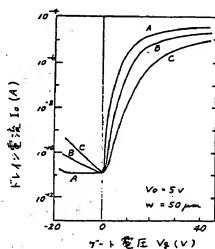


第3図



- 1...絶縁基板
2...ゲート絶縁膜
3...ゲート電極
4... n^+ ドレイン領域
5... n^+ ソース領域
6...層間絶縁膜
7...コンタクト電極
8... n チャネル領域
9... n ウェル領域
10... n ウェル層

第4図



- A: $N_L = 5 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3} \text{ eV}^{-1}$
B: $N_L = 2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3} \text{ eV}^{-1}$
C: $N_L = 5 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3} \text{ eV}^{-1}$